PAT-NO: JP358196232A DOCUMENT- JP 58196232 A

IDENTIFIER:

TITLE: PRODUCTION OF ELECTRICALLY CONDUCTIVE OR

SEMICONDUCTIVE POLYMER COMPOSITION

PUBN-DATE: November 15, 1983

INVENTOR-INFORMATION:

NAME COUNTRY

HOTTA, OSAMU HOSAKA, TOMIJI SONODA, NOBUO

SHIMOMA, WATARU

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD N/A

APPL-NO: JP57080894 APPL-DATE: May 13, 1982

INT-CL C08G085/00 , C08G073/00 , C08G079/00 , C08L085/00 , (IPC): H01B003/30

US-CL-CURRENT: 205/419

ABSTRACT:

PURPOSE: An electrolytially oxidizable substance such as benzene is subjected to electrolytic oxidation with an anode of a metal oxide semiconductor in the presence of a dopant to permit easy and simple production of films of electrically conductive or semiconductive polymer composition.

CONSTITUTION: At least one of electrolytically oxidzable substance selected from benzene, its derivatives such as phenol, five-membered heterocyclic ring compounds containing oxygen or nitrogen atom such as thiophene and compounds containing a benzene ring and a five-membered heterocyclic ring where the two rings are connected directly

or through an ether bond into a linear form such as 2-phenylthiophene is subjected to electrolytic oxidation with an anode of a metal oxide semiconductor such as tin oxide in the presence of a dopant such as tetraethylammonium borofluoride to product the objective electrically conductive or semiconductor polymer composition.

USE: A material for electronic devices.

COPYRIGHT: (C)1983, JPO&Japio

(9) 日本国特許庁 (JP)

10 特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭58-196232

| 50Int. Cl.3 | 識別記号 | 庁内整理番号 | ❸公開 昭和58年(1983)11月15日 |
|--------------|------|----------|-----------------------|
| C 08 G 85/00 | | 7445—4 J | |
| 73/00 | | 7445—4 J | 発明の数 1 |
| 79/00 | | 7445—4 J | 審査請求 未請求 |
| C 08 L 85/00 | | 7445—4 J | |
| H 01 B 3/30 | | 8222-5E | (全 4 頁) |
| H 01 B 3/30 | | 8222-5E | (全 4 頁) |

50進電性ない1.半導雷性重合体組成物の製造法

②特 願 昭57-80894

②出 願昭57(1982)5月13日

70発 明 者 堀田収

門真市大字門真1006番地松下電器産業株式会社内

70発 明 者 保阪富治

門真市大字門真1006番地松下電器産業株式会社内

⑩発 明 者 園田信雄

門真市大字門真1006番地松下電 器産業株式会社内

70発 明 者 下間亘

門真市大字門真1006番地松下電

器産業株式会社内

⑪出 願 人 松下電器産業株式会社 門真市大字門真1006番地

邳代 理 人 弁理士 中尾敏男 外1名

明 細 書

1、発明の名称

導電性ないし半導電性重合体組成物の製造法 2、特許請求の範囲

(17) (a)ペンセまたはその誘導体、(b)酸素族元素 または健素族元素を1つ含む核素五具環化合物、 及び(a)ペンセン環と酸素族元素されは複数個の環か 直接またはエーテル、スルフィド、セレニド、ナ ルリド結合のうち、どれかの結合を介してなく 結合した化合物よりなる群から選んだ少なく は一つを、不純物との共存下に金属酸化物半導体 低で、電解酸化するととを解散とかみ電性ない し半導電性氧合体組成物の製造法。

(5) 金属酸化物半導体が、酸化スズ、酸化インジ ウム、不純物を含む酸化スズ、及び不純物を含む 酸化インジウムよりなる群から選ばれた特許請求 の範囲第1 須配敷の導電性ないし半導電性電合体 相減物の製造法。

(3) 金属酸化物半導体が膜状形態にある特許請求

の範囲第1項または第2項記載の導電性ないし半 導電性重合体組成物の製造法。

(4) 酸素族元素がイオウ、セレン、テルルのうちのどれかである特許請求の範囲第1~3項のいずれかに配載の導電性ないし半導電性重合組成物の製造法。

(6) 不純物がホウハロダン化イオン、パーハロダ ネートイオンまたは破酸イオンを含む化合物もし くはて, 7, 8,8ーテトラシアノキノジメタン 誘導体から選ばれた特許請求の範囲第1~4項の いずれかに配載の導電性ないし半導電性重合体組 成物の製造法。

3. 発明の詳細な説明

本発明は、導電性ないし半導電性取合体組成物の製造方法に係り、とくにフィルム状の重合体組成物を得る方法に関する。

後来、たとえば、K.Keiji Kanazawa et al.,J.Chem.Soc.Chem.Comm.,854(1979) などに支持電解質の存在下でピロールを電解機化 して白金陽極板上に導電性重合体組成物を製造す る方法が記載されている。同様の方法でチォフェンやペンセンまたはこれらの誘導体を酸化して、自金を金能板上に導電性もしくは半導電やの成成は、電板で強く付着して剝離するときに従いいまなしてフィルム状の超成物として得にくいっまた自金や金は高値でおり、大面積のフィルム状組成物を全値に得るの世界製である。さら低、、 医角 以外の金属を勝板に用いたときは、 陽極に表れて重合体組成地様にくくをな。

これらの事情を考慮して、本発明はとくに、フィルム状の専高性ないし半導電性重合体組成物を 簡便に得る方法を提供するものである。

本発明は電解酸化物質(本発明において陽極で 電解酸化される物質をとう称する)を不純物との 共存下に金属酸化物半導体陽極で、電解酸化する ことを特徴とする。

金属限化物半導体には、たとえば、亜酸化銅、 酸化亜鉛、酸化インジウム、酸化スズ、酸化チタ ン、酸化コパルト、酸化ニッケル、五酸化タジタ

不純物には有機図板 アンモニウム塩、無機塩、 プロトン酸や電子受容 休として知られている化合物があり、例えばホウ赤化テトラエテルアンモニウム、 過塩素酸テトラーロープテルアンモニウム、 現化テトラメナルアンモニウム、 選塩素酸マグネ ンウム、 研管 パリウム、 配酸、 テトラシアノエテレン、 ア, ア, 8,8-テトラシアノキノンメリーペングキノン、 Pーフルオラニル、1,3,6、8-アトラシアノピレン、 フタロジニトリル、 2,4,7-トリニトロフルオレノンなどがある。

電優として用いる金属酸化物半導体は、電優と 1. て十分に大きな導電性を有し、かつ陽極に用い ル、五酸化パナジウム、三酸化タングステン、三 酸化モリブデン むよび これらの化合物に不純物を ドープしたものなどがある。

- 本発明で用いる電解酸化物質は、次のような化 合物群から選択される。
 - (a) ベンゼンまたはその誘導体、
 - (b) 酸素族元素もしくは窒素族元素を1つ含む 複素五員環化合物、
- (c) ベンゼン環と酸素族元素もしくは窒素族元素を1つ含む複素五泉環から調ばれた複数側の環が直接またはエーテル、スルフィド、セレニド、テルリド約合のうちのどれかの結合を介して複雑状に結合した化合物、

とくに、線状の金属酸化物半導体が基体に支持 されている場合、なかでもたとえば、アンチモン をドープした酸化スズや、スズをドープした酸化 レンウウムをガラスや樹脂組成物基体上にとりつ けたものは、任意の形状や面積のものが容易に得

神器858-196232 (3)

られるので、それに応じて種々の形状、面積をもった重合体組成物が得られる。とりわけ、大面積 のものも容易に得られるので効果が大きい。

次に実施例を挙げて本発明をさらに詳しく説明 する。

種々の電解酸化物質5g、不統物1g とを破骸 ジメテル500㎡に存解させ、さまざまな条件で 電解酸化物質を酸化し、それぞれ、アンチモンを ドーブした酸化スズかよびスズをドーブした酸化 インジウムを薄膜状状とりつけたガラス電極の膨 低上伏大きさ10mx20mmのフィルム状の博電 性または半導電性重合体組成物を得た。これをカラス電極ごとメタノールに浸漉して重合体組成物 を電極から刺離し、さらにメタノールで洗浄した 後代一般表表学宏鏡した。この重合体組成物から 大きさ1mx10mmのものを2枚切りとり、図館 子技による場電※額定用試料とした。

表に電解酸化物質と不純物の種類、電解酸化の 条件および導電率の値(2試料の平均値)を示す。

| - | 1. | 751 | |
|---|----|-----|--|
| | | | |

| | 不純物の角類 | 電解機化の条件 | 海電客 (Ø ¹ cm ⁻¹) | |
|-----------|--------------------------------|-----------------------|--|----------------------|
| 電解酸化物質 | | | 酸化スズ | 酸化 インジウム |
| チオフェン | ホウ赤化テトラ - n - ブラルア ンモニウム | 5 π A ∕cel 1 0 97- | 6.3 | 7. 8 |
| チオフェン | 遊塩末酸テトラ エチルアンモニ ウム | 5 m A /cml 10/3 | 1.6×10 | 1.2 × 1 0 |
| チオフェン | 7,7,8,8・テト ランアノキノジ メタン | 1 m A / call 3 0 分 | 5.2×10 ⁻² | 3.6×10 ⁻² |
| チオフェン | GE BR | 1 m A /cml 3 0 g/ | 8.8×10 ⁻² | 1.5×10 ⁻¹ |
| フェノール | ホウ弗化テトラ - n - プチルア ンモニウム | 5 m ∧ /cml 1 0 分 | Z 1×10 ⁻⁸ | 4.6×10 ⁻⁸ |
| ジフェニルエーテル | 必塩素酸テトラ - n = プチルア ンモニウム | 5 as A /cel 10/3 | 3.4×10 ⁻⁵ | 4.8×10 ⁻⁶ |

| ピロール | ホウ弗化テトラ エチルアンモニ ウム | 5 m ^ /cml 1 0 97 | 5.8×10 | 2,7×10 |
|-------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| セレノフェン | 過塩素酸テトラ エチルアンモニ ウム | 5 m A /cml 1 0 分 | 1.6×10 ² | 2.2 × 1 0 ² |
| テルロフェン | 過塩素酸テトラ エチルアンモニ ウム | 5 m ^ /cml 1 0 57 | 6.1×10 | 4,2×10 |
| 2 - フェニル チオフェン | ホウ弗化テトラ エチルアンモニ ウム | 5 m A /cm² 1 0 % | 4.3×10 ⁻⁵ | 3.9×10 ⁻⁵ |
| 2 - (α - チャニル) チオフェン | 値段アンモニウム | 1 m A /cel 3 0 5} | 2.9 × 10 ⁻³ | 7.7×10 ⁻⁴ |
| 2 - (2 - ピロリル) ピロール | 過塩素酸マグネ シウム | 1 m A / cml 3 0 /2+ | 19×10 | 2.6×10 |

また、金属酸化物半導体の焼結板や金属酸化物 半導体粉末を押し固めたものを陽極に用いた場合 も上記実施例と同様にフィルム状の重合体組成物 を得ることができた。

さらに、不純物の複類や量、電解限化の条件などを適当に選んで標本の電解限化物質から同様なフィルム状の重合体組成物を得た。これらの重合体組成物とはいずれも10⁻¹²(ロ·m)⁻¹以上の導電率の値を示した。

本発明の方法で得たフィルム状形態のものをは じめとする東合体組成物は、たとえば電子デバイ スなどの素材として広汎な用途に用いられる。 代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名